科学研究費助成事業

研究成果報告書



研究成果の概要(和文):物質からの電子回折図形を用いた全く新しい位相イメージング法を開発した。これま で定量的な位相計測の妨げとなっていた様々な要素を洗い出して対処法を考案し、物質を透過した電子波動関数 の位相分布を約0.1ラジアンの精度で結像する手法の確立に成功した。既存の位相計測手法(電子線ホログラフ ィー法)と比べての優位性と有効性、汎用性を明確に示す結果を得ることに成功した。また原子分解能での波動 場再構成とそのフレネル伝播解析からナノスケールでの新たな三次元観察法の可能性を示すことに成功し,原子 レベルからミクロンレベルまでの様々な対象を観察可能な結像法開発を達成した。

研究成果の概要(英文): We developed a novel electron phase-imaging method based on an electron diffraction pattern. We devised each processing method to cope with various factors preventing quantitative phase measurements, and thus succeeded in establishing the phase-imaging method which enables mapping of phase distributions of electron wave functions after passing through materials to an accuracy of about 0.1 radian. We demonstrated availability and versatility of our method, and showed superiority to the existing phase-imaging method (off-axis electron holography). We also showed possibilities of new kinds of nanometer-scaled three-dimensional observation methods based on analyzing Fresnel propagation phenomenon of the exit wave functions. Thus we achieved developing a new imaging method available for observing atomic-, nanometer-, and micron-sized various materials and showed great capabilities for applications to quantitative measurements of electromagnetic fields in and around materials.

研究分野:電子顕微鏡学

キーワード:電子回折 位相イメージング 回折顕微法

1.研究開始当初の背景

本課題研究で取り組んだ「回折顕微法」は、 フーリエ変換を含むイタレーション演算を 通じて回折図形強度から試料構造を再構成 する手法である。入射電子波が試料を透過し た際の実空間複素波動場が対物レンズの影 響を受けずに再構成されるため、これまでは 一部の例外を除き、10nm 程度の視野内での原 子配列の再構成に研究者の興味は限定され ていた。荷電粒子である電子は、試料中の構 成原子や試料周辺の電磁場を通過する際に 波動関数の位相変調を受ける。回折顕微法で は試料下面の複素波動関数を再構成するた め、この位相変調が視覚化される。したがっ て本来 TEM 像では見ることのできない試料透 過電子線波動場を原子スケールからミクロ ンスケールの視野範囲にわたって可視化で きるはずである。

この着眼点に基づいた研究開始点として、 ナノスケール電磁場の最もシンプルな形態 として物質内の原子の集合が形成する静電 ポテンシャル(平均内部ポテンシャルと呼ば れる)の可視化に既に成功している(図1) [1]。このように従来よりもかなり広い視野 の位相像を得るには小角散乱図形を計測す る必要があるが、そのための実験条件や装置 構成などについても、基本的な部分について は判明していた(次節)。このように見通し が大きく開けたところではあったが、定量性 のある計測手法としての実用化までには課



図1 小角散乱図形(左)からくさび形状 試料の透過電子位相像を再構成[1] 題山積という状況であった。

2.研究の目的

電子線小角散乱を用いた全く新しい位相 イメージング法を確立することを第一の目 的とした。データ定量性の確保、汎用性の増 強、データ処理作業の簡素化と自動化、の3 つを達成することにより、手法の実用化を成 し遂げる。また、同じく電子線位相を観察す る手法として定着している電子線ホログラ フィーは幾つかの難点を抱えており、本手法 の優位性を明らかに示すデータの取得を第 二の目的とした。また試料透過した電子線波 動場を原子スケールで正確に再構成した波 動場の真空中伝播 (フレネル伝播)特性を調 べ、新たなナノスケール三次元観察法の開発 を目指した。これらによって原子レベルから ミクロンレベルまで観察可能な新規電子線 位相イメージング法の確立を目指した。 3.研究の方法

広視野の位相イメージングを行うに当た っての本手法の利点の一つは、電子線バイプ リズムなどの高額な器具を取り付けること なく、現在透過型電子顕微鏡の標準的な装置 構成として普及しているエネルギーフィル ター装備の電界放出型 200kVTEM で実験が行 える点である。本手法の原理が実空間波動場 と逆空間波動場のフーリエ変換に立脚して いるため、高い電子ビーム干渉性を実現する ための電界放出型電子銃が必要である。また これまでの研究により、物質を透過した電子 線から非弾性散乱した成分を除去する重要 性が判明しているため、エネルギーフィルタ ーを用いたこれらの除去が必要である。特に ポストコラムタイプのフィルターを用いる ことにより、電子顕微鏡に標準設定されてい るカメラ長(一般に 2m 程度)では十分には 拡大記録できない小角散乱成分を、10-20 倍 程度拡大して詳細に記録できることが重要 である。

一方、原子レベルの位相像を有限ピクセル 数の離散データとして再構成するためには、 必然的に視野サイズを限定する必要がある。 そのため独自に加工した極小サイズの絞り を用いて数 nm の領域を選択する必要がある。 この場合に問題となるのが対物レンズ収差 による視野の回り込み(制限視野回折におけ る領域選択誤差)の現象である。これを抑え るために、原子レベル再構成の実験には対物 レンズの収差補正装置を持つ電子顕微鏡を 用いた。

4.研究成果

(1) 再構成位相像の定量性の達成

再構成結果の定量性を妨げる要因を徹底 的に洗い出し、下記の3つに分類されること を明らかとした後、それぞれの対処法を考案 した。

回折図形強度記録の非定量性

CCD カメラで記録する際のリードアウトノ イズや、強いビームを記録した際の残光に起 因すると思われる不均一なバックグラウン ド強度が発生してしまうことが判明した。こ れらの問題に対し、短時間露光での連続撮影 (50 枚程度)を行い、事後に位置合わせをし て足し合わせる解決法を開発した。またこの 手法は、記録時間中の回折図形のドリフトの 影響を極小化することにも効果を発揮した。 制限視野領域のズレ

本手法で使用する電子回折図形は透過型 電子顕微鏡における「制限視野回折法」を用 いて取得し、制限視野絞りの入った拡大像を 拘束条件として位相像を求める。このため3 節で述べたように、原子分解能再構成の場合 は収差補正装置が必須である。一方100m以 上の広視野再構成の場合は原理的に問題化 しないはずであるが、実験においては別の要 因によって、電子回折図形取得時の絞り位置 と拡大像記録時の絞り位置にズレが発生し ていることが判明した。この影響をシミュレ ーションを用いて具体的に検証した結果、再 構成位相像の定量性を確保する上で無視で きない影響を及ぼすことが判明した。

このズレの生じる原因として、電子回折図 形記録時間中の試料ドリフト、および電子顕 微鏡の拡大像モードから電子回折モードへ の切り替え時に発生するレンズ漏れ磁場の 変化が大きく作用していることを解明した。 前者への対策としては、試料移動後に十分ド リフトが止まってから電子回折図形を取得 することで回避可能と判明し、後者に関して はエッジを持つ試料を用いた像シフト量の 計測方法を編み出した。さらに再構成波動場 と電子回折図形実験データとの矛盾量を最 小化するようにピクセル単位で位置合わせ を達成する方法を確立した。



図2 Airy 図形へのフィッティング計算によ る点拡がり関数とレンズ収差係数の同時決定

記録した回折図形のボケ

電子顕微鏡の制限視野絞り(円形開口)を 用いた回折図形(いわゆる Airy 回折図形) を計測したところ、理想的なフーリエ変換図 形と比べてボケ(点拡がり関数)を含んでい た。このボケの要因として、電子ビームの不 完全な空間干渉性、集束レンズと中間レンズ 群の収差、CCD カメラ記録時の「にじみ」、な どを特定した。これらの影響を定量的に計測 するために、点拡がり関数の標準偏差とレン ズ収差係数(2 次収差まで)をパラメータと して、上記の Airy 図形の記録強度にフィッ ティングする手法を開発した。図2にその一



渉性を定量的に計測するのは一般に困難と され、電子線バイプリズムを用いた注意深い 実験と解析が必要とされるが、図3に示した ようにビーム径の拡大に比例した干渉長の 増大を精度良く捉えることに成功しており、 本課題研究遂行における副次的成果として 新しい電子ビーム干渉性計測の手法を確立 することに成功した。

このようにして精密に決定した点拡がり 関数を使って、計測した回折図形をデコンボ リューション処理(ボケを取り除く処理)し、 さらに各収差係数から合成したレンズによ る位相変調を差し引くことによって、回折図 形のボケの影響をほぼ完全に取り除く手法 を確立することに成功した。その手順の模式 図を図4に示す。



図4 ボケ関数とレンズ収差の影響除去手順

上述の様々な処理手法の開発とその適用 の結果、図4下段に示したように、一般的な 電子線ホログラフィーでの計測結果と同等 以上の約0.1 ラジアンの位相計測精度を達成 することに成功した。またこれらの処理手順 を確立する過程で、様々なツール開発による 作業の簡素化と自動化を増進した。

(2)電子線ホログラフィー法に対する優位性の検証

既存の位相イメージング手法である電子 線ホログラフィーの最大の難点は、観察領域 に近接した真空領域が必要とされる点であ り、試料形態の自由度の点でしばしば大きな 制約となっている。本課題研究で開発した手 法の利点は、この隣接真空領域を必要としな い点である。このため試料エッジから遙かに 遠く離れた試料領域の位相像を問題なく取 得することが可能である。この利点を明示す るためのデモンストレーションデータを図 5に示すように取得することに成功した。 また電子線ホログラフィーではたとえ隣 接真空領域があっても、その空間に電磁場が 存在すると正しい計測が行えないことも大 きな問題点として知られている。この点でも 本手法は威力を発揮し、図6に示すように帯 電したナノ粒子近傍に広がる電磁場分布を 明瞭に可視化することにも成功した。



図 5 近接真空領域を必要としない位相イメ ージング



<u>TEM image</u>Phase image 図 6 帯電した絶縁体ナノ粒子周囲に広がる 電場の計測

(3) 位相像連結による視野範囲の拡大

ここまで記述した成果は、単一の制限視野 絞り内の位相像再構成に関するものであり、 視野範囲は絞り直径(試料位置で 100-200nm 程度)に限定されるものである。手法の実用 化に不可欠な視野の拡大を達成するために、 複数の隣接領域から順次制限視野回折図形 を取得した後に各領域での再構成位相像を モンタージュ的につなぐ手法の確立に取り 組んだ。

図7(a)は制限視野絞りと対物レンズ像面 の位置関係を偏向レンズを用いて変化させ ながら、丸で囲った領域から回折図形を逐次 取得したデータである。これを基に再構成し た各領域の位相像を結合した結果が図7(b) である。図4に示した手順でレンズ収差の影 響を取り除いたデータを用いたことで始め て、このように矛盾なくつながる位相像を得 ることが可能となった。この初期的な成果を 今後拡張することにより、1ミクロン以上の サイズの視野にわたって位相像を取得する ことが可能と期待される。

(4)フレネル伝播を用いたナノスケール三次 元観察法の開発

試料透過した複素波動場は真空中をフレネル伝播する距離に応じて振幅、位相ともに 変化する。したがって試料透過波動場を定量



図7 位相像の連結による視野拡大

的に計測することができれば、ナノ構造の三 次元情報を読み解くことが可能となる。本課 題研究では二通りの方法でこの問題に取り 組んだ。一つ目は、収差補正電子顕微鏡(TEM) の対物レンズ焦点位置を順次変更しながら 多数枚の像(フォーカスシリーズ)を取得す る方法であり、フレネル伝播に伴う振幅変化 をトレースすることによって TEM 像中のナノ 粒子の深さ方向(電子線進行方向)の位置情 報を読み取ることに成功した。二つ目は、回 折イメージングによって複素波動場を再構 成する方法であり、フレネル伝播を逆算する ことによって試料の三次元情報を得ること が可能となる。この計算を正しく行うために は、試料面位置の振幅・位相分布を単に可視 化すればよいのではなく、振幅変化量と位相 変化量の定量計測が求められる。Si 結晶を透 過した波動場の原子レベル再構成結果[2]に 基づきフレネル伝播計算を行ったところ、シ ミュレーション結果とよく一致する三次元 伝播特性を再現することに成功し(図8) ナノスケールレベルでの三次元観察に向け た可能性を示すことに成功した。

(5)今後の展望

ここまで記述した様々な成果を通じて、本手 法の優位性と有効性、汎用性を明らかに示す ことに成功し、新たな顕微イメージング法を 確立できたと言える。今後の応用的観点から は、半導体デバイスのドーパント分布計測、 磁性ナノ材料のドメイン構造や漏洩磁場の 精密測定、ナノデバイス材料中の結晶歪みマ ッピング、低エネルギー電子線によるバイオ マテリアルの高感度結像やトモグラフィー 観察などに可能性が広がり、計測科学の新し い分野としての展開に期待が膨らむ。またレ ンズ結像を直接用いない点において電子顕 微鏡学におけるパラダイム転換を誘起する ものであり、学会に与えるインパクトは大き いものと期待される。



図 8 (a) 電子回折図形から再構成した Si 結晶を透過した波動場 (b) 図(a)中の 破線部分のフレネル伝播計算 (c) シミュ レーション波動場のフレネル伝播計算

<引用文献>

[1] J.Yamasaki, K. Ohta, S. Morishita, and N. Tanaka, Applied Physics Letters,101 (2012) 234105.
[2] S.Morishita, J. Yamasaki, K.Nakamura, T. Kato, and N.Tanaka, Applied Physics Letters, 93(2008)183103.

5.主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線) [雑誌論文](計4件)

1. <u>山崎 順</u>,「結像系収差補正電子顕微鏡(収 差補正TEM)を駆使した微細構造解析手法の進 展」触媒, 59, 82 (2017). 査読有り https://www.shokubai.org/jnl/pageview?ar ticlecd=59020006000

2. <u>山崎 順</u>, 島岡勇記, <u>佐々木宏和</u>「電子回 折位相イメージング法の開発とナノ電場の可 視化」まてりあ, 55, 595 (2016). 査読有り DOI: 10.2320/materia.55.581

3. <u>J. Yamasaki</u>, M. Mori, A. Hirata, Y. Hirotsu, and <u>N. Tanaka</u>, "Depth-resolution imaging of crystalline nanoclusters attached on and embedded in amorphous films using aberration-corrected TEM", Ultramicroscopy 151, 224 (2015).査読有り DOI: 10.1016/j.ultramic.2014.11.005

4. 山崎 順,「収差補正TEMにおける高さ分解

能と三次元ナノ構造情報の検出」 顕微鏡 49, 216 (2014). 査読有り

〔学会発表〕(計20件)

1. <u>山崎 順</u>,「電子回折図形に基づく位相イ メージング法」,日本顕微鏡学会 第 59 回シ ンポジウム,2016 年 11 月 18,19 日,帝京平 成大学池袋キャンパス(東京都・豊島区) 招 待講演

2. <u>H. Sasaki</u>, S. Otomo, R. Minato, J. Yoshida1, K. Yamamoto, T. Hirayama, <u>J.</u> <u>Yamasaki</u> and N. Shibata, "Analysis of GaAs compound semiconductors and the semiconductor laser diode using electron holography, Lorentz microscopy, electron diffraction microscopy and differential phase contrast STEM." The 16th European microscopy congress (EMC2016), August 28-September 2, Lyon ($\Im \Im \Im \Im$)

3. <u>J. Yamasaki</u>, Y. Shimaoka, and <u>H. Sasaki</u>, "Refined Phase Imaging by Electron Diffractive Imaging", Microscopy and Microanalysis 2016 Meeting (M&M2016), 24-28 July 2016, Columbus (アメリカ)

4. <u>J. Yamasaki</u>, Y. Shimaoka, and <u>H. Sasaki</u>, "Developing Quantitative Phase Imaging by Electron Diffractive Imaging", The 5th International Symposium on Advanced Microscopy and Theoretical Calculations (AMTC5),11–13 May 2016, WINC Aichi (愛知 県・名古屋市)

5.<u>山崎 順</u>, 島岡 勇記, <u>佐々木 宏和</u>,「電子 線回折を用いた定量的位相イメージング法」 日本顕微鏡学会 第72回学術講演会,2016年 6月14-16日,仙台国際センター(宮城県・仙 台市)

6. 島岡 勇記,<u>山崎 順</u>「電子線小角散乱を 用いた回折位相イメージングの高精度化」 日本物理学会 2015 年秋季大会、2015 年 9 月 16-19 日、関西大学千里山キャンパス(大 阪府・吹田市)

7. <u>H. Sasaki</u>, S. Otomo, R. Minato, K. Yamamoto, T. Hirayama, <u>J. Yamasaki</u> and N. Shibata, "Analysis of GaAs compound semiconductors and the semiconductor laser diode using off-axis electron holography, Lorentz microscopy, electron diffraction microscopy and differential phase contrast", Microscopy and Microanalysis 2015 Meeting, 2-6 Aug. 2015, Portland (アメリカ)

8. <u>Jun Yamasaki</u>, "Reconstruction of Atomic Structures and Electric Fields of Nano Materials Using Electron Diffractive Imaging", International Conference on Electron Microscopy and XXXVI Annual Meeting of the Electron Microscope Society of India (EMSI-2015), 8-10 July 2015, Mumbai(インド)基調講演

9. <u>J. Yamasaki</u>, A. Hirata, Y. Hirotsu, K. Hirahara, and <u>N. Tanaka</u>,

"Depth-Resolution Imaging of Crystalline Nano Clusters on/in Amorphous Films Using Aberration-Corrected TEM", Third Conference on Frontiers of Aberration Corrected Electron Microscopy (PIC02015), 19-23 April 2015 Kasteel Vaalsbroek (オランダ)

10. <u>J. Yamasaki</u>, A. Hirata, Y. Hirotsu, K. Hirahara, and N. Tanaka, "Depth-Resolution Imaging of Crystalline Nano Clusters Using Aberration-Corrected TEM", The 2nd East-Asia Microscopy Conference (EAMC2), 24-27 November 2015 姫路商工会議所(兵庫県・姫路市)

11. <u>佐々木宏和</u>,大友晋哉,山本和生,平山司,<u>山崎順</u>,柴田直哉「各種電子顕微 鏡法による半導体中の電位分布解析」日本顕 微鏡学会第71回学術講演会,2015年5月 13-15日,京都国際会館(京都府・京都市)

12. 島岡 勇記, <u>山﨑 順</u>「Airy ディスクを用 いた電子線空間干渉性の計測と回折顕微法」 日本顕微鏡学会 第 71 回学術講演会、2015 年 5 月 13-15 日、京都国際会館(京都府・京都 市)

13.山<u>崎</u>順,平田秋彦,弘津禎彦,平原佳織, <u>田中信夫</u>「収差補正 TEM による結晶性ナノク ラスターの深さ分解能結像」日本顕微鏡学会 第71回学術講演会、2015 年 5 月 13-15 日、 京都国際会館(京都府・京都市)

14. 山崎 順「収差補正 TEM による深さ分解 能結像」日本顕微鏡学会 超高分解能顕微法 分科会 2014 年度研究会、2015 年 2 月 20,21 日、マホロバ・マインズ三浦(神奈川県・三 浦市)招待講演

15. <u>Jun Yamasaki</u>, "Electron Diffractive Imaging of Crystalline Structures and Electric Fields in/around Nano Materials ", the 18th SANKEN International Symposium, 10-11 December, 2014, Knowledge Capital Congres Convention Center (大阪府・大阪 市)招待講演

16. <u>J. Yamasaki</u>, K. Ohta, <u>H. Sasaki</u>, and <u>N. Tanaka</u>, "Observation of electric field using electron diffractive imaging", 18th

International Microscopy Congress (IMC 2014) 7–12 September 2014, プラハ(チェコ)

17. <u>Jun Yamasaki</u>, "Electron Diffractive Imaging of Crystalline Structures and Electric Fields of Nano Materials", The 15th International Union of Materials Research Society - International Conference in Asia (IUMRS-ICA), 24-30 August, 2014, Fukuoka University(福岡県・ 福岡市)招待講演

18. <u>山崎 順</u>「電子線の空間コヒーレンス測 定と電子線回折イメージング」日本放射光学 会第6回若手研究会「コヒーレントX線が拓 く構造可視化の新しい世界」、2014 年8月 21,22日、理研播磨 SPring-8(兵庫県・佐用 町)招待講演

19. <u>Jun Yamasaki</u>, "Phase Imaging by Electron Diffractive Imaging", Holo Workshop, 10–12 June 2014, Dresden (ドイ ツ)

20. <u>佐々木宏和</u>,大友晋哉,山本和生,平 山 司,<u>山崎 順</u>,谷垣俊明,明石哲也「位 相回復法を用いた半導体解析」日本顕微鏡 学会 第70回学術講演会、2014年5月11-13 日、幕張メッセ(千葉県・千葉市)

 【図書〕(計1件)
 1.「機能構造科学入門 3D 活性サイトと物質 デザイン」 丸善出版(2016), pp.57-75, 4章
 1節「回折イメージング」,郷原一寿, 山崎 順, 塩谷浩之

〔その他〕 ホームページ等 http://www.uhvem.osaka-u.ac.jp/ele/cust om2.html

 6.研究組織
 (1)研究代表者
 山崎 順(YAMASAKI JUN)
 大阪大学・超高圧電子顕微鏡センター・准 教授
 研究者番号:40335071

(2)研究分担者
 佐々木 宏和(SASAKI HIROKAZU)
 古河電気工業株式会社・研究開発本部横浜
 研究所・その他
 研究者番号: 70649821

(3)連携研究者
 田中 信夫(TANAKA NOBUO)
 名古屋大学・未来材料・システム研究所・
 特任教授
 研究者番号:40126876